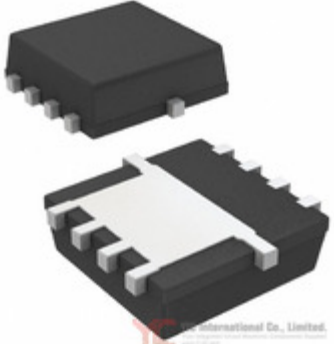

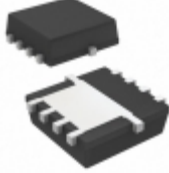
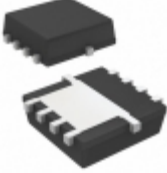



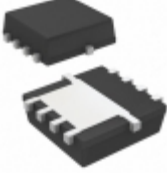
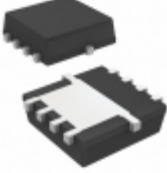

	<h2 style="color: red;">SI7110DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7110DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8
	Datenblätter:  SI7110DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 81173 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7110DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	81173 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 21.1A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7110DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 13.5A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.5A (Ta)

SI7110DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7110DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7110DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7110DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7110DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8</p>	 <p>SI7111EDN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 60A 1212-8</p>	 <p>SI7108DN-T1-E3 VISHAY SI7108DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7110DN VISHAY VISHAY QFN-8</p>
 <p>SI7112DN-T1 VISHAY SI7112DN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7110DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8</p>	 <p>SI7111EDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 60A POWERPAK1212</p>	 <p>SI7112DN VISHAY VISHAY QFN-8</p>

SI7110DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7110DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7110DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7110DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7110DN-T1-GE3
SI7110DN-T1-GE3 Electronic	SI7110DN-T1-GE3-Komponenten	SI7110DN-T1-GE3-Verteiler	SI7110DN-T1-GE3-Bild	SI7110DN-T1-GE3 Teil	SI7110DN-T1-GE3-Inventar
SI7110DN-T1-GE3 Preis	SI7110DN-T1-GE3 Hersteller	SI7110DN-T1-GE3 Bild	SI7110DN-T1-GE3 Aktie	SI7110DN-T1-GE3 Inventar	SI7110DN-T1-GE3 Online bestellen
SI7110DN-T1-GE3 Neu	SI7110DN-T1-GE3 Original	SI7110DN-T1-GE3 garantiert	SI7110DN-T1-GE3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited